

3/4 (1. Halbttag) | Transistor und Transistorverstärker

Angelo Brade^{*1} and Jonas Wortmann^{†1}

¹Rheinische Friedrich–Wilhelms–Universität Bonn

5. September 2024

^{*}s72abrad@uni-bonn.de

[†]s02jwort@uni-bonn.de

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Einleitung | 1 |
| 2 | Theorie | 1 |
| 3 | Voraufgaben | 1 |
| 3.1 | A | 1 |
| 3.2 | B | 1 |
| 3.3 | C | 1 |
| 3.4 | D | 2 |
| 3.5 | E | 2 |
| 3.6 | F WIP Schaltkreis | 2 |
| 4 | Auswertung | 2 |
| 4.1 | Kennlinien und Arbeitspunkt | 2 |
| 5 | Fazit | 5 |

1 Einleitung

In diesem Versuch werden bipolare und Feldeffekttransistoren behandelt; ihr Aufbau, physikalische Funktionsweise und Integration in Schaltungen werden verstanden. Konkreter soll die Ausgangskennlinie sowie Arbeitsgerade und Arbeitspunkt eines npn-Transistors und FETs mit Hilfe eines Kennlinienschreibers und Oszillographen vermessen werden.

2 Theorie

Es gibt zwei verschiedene Arten von Transistoren; Bipolar- und Feldeffekttransistor. Der Bipolartransistor

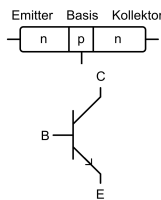


Abbildung 1: Schaltbild und Aufbau eines Bipolartransistors; Abbildung 3/4.1 a) [1]

ist aufgebaut aus zwei n-dotierten Materialien (Emitter und Kollektor), wobei der Emitter deutlich stärker n-dotiert ist als der Kollektor. Die Basis ist nur sehr dünn und leicht p-dotiert.

Wird nun an der Basis ein geringer Strom angeschlossen und es herrscht eine Spannung zwischen Emitter und Kollektor, so fließen Elektronen aus dem Emitter in die Basis und füllen dort die p-Löcher auf. Da die Basis allerdings nicht alle Elektronen des Emitters aufnehmen kann, und eine Spannung zwischen Emitter und Kollektor anliegt, fließen die Elektronen des Emitters direkt weiter in den Kollektor. Obwohl zwischen Basis und Kollektor die Sperrichtung ist, fließen die Elektronen trotzdem, da die Sperrung bereits durch den Strom aus dem Emitter in die Basis aufgehoben worden ist. Zudem wirkt eine Kraft auf die Elektronen in Richtung Kollektor durch das starke Feld zwischen Basis und Kollektor.

Der FET (**F**eldeffekt**t**ransistor) ist ein Transistor der ein elektrisches Feld als Analogon zum Basisstrom des Bipolartransistors verwendet. Er ist aufgebaut aus Source, Drain, Gate und Bulk. Source und Drain sind beide n-dotiert und Bulk ist p-dotiert.

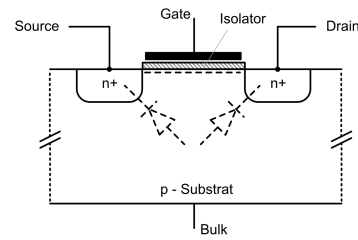


Abbildung 2: Aufbau eines FET; Abbildung 3/4.8 [1]

Zwischen Gate und Bulk ist eine dünne isolierende Schicht, welche den Transistor vor der am Gate anliegenden Spannung isoliert. Die Spannung am Gate sorgt dafür, dass ein Feld zwischen Source und Drain entsteht, welches die Elektronen dicht unterhalb der Isolierschicht passieren lässt. So kann durch Regulation der Gatespannung der Stromfluss kontrolliert werden. FET mit typischem Isolierschichtmaterial Metall-Oxid-Silizium werden MOSFET genannt.

Sowohl der Bipolartransistor als auch der FET sind beide fähig den Stromfluss zu verstärken (über Basisstrom und Gatespannung), sowie ein- und auszuschalten.

3 Voraufgaben

3.1 A

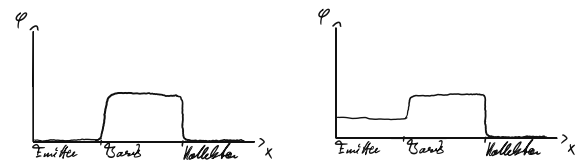


Abbildung 3: Potentialverlauf ohne (links) und mit (rechts) äußerer Spannung

3.2 B

Im Emitter ist eine hohe Elektronendichte; in der Basis ist nur eine geringe Löcherdichte; im Kollektor ist eine weniger starke Elektronendichte als im Emitter.

3.3 C

Es gilt

$$I_E = I_B + I_C \quad \beta = \frac{dI_C}{dI_B} \quad \alpha = \frac{dI_C}{dI_E} \quad \gamma = \frac{dI_E}{dI_B}. \quad (1)$$

Die genaue Verschaltung lässt sich unter 3.1.2 Kennlinien und Arbeitspunkt[1] in der Praktikumsanleitung nachlesen. Kurzgefasst, benutzen wir Wechselspannung, um ein Bereich der Kollektor-Spannung für verschiedene Basis-Ströme, welchen wir mithilfe eines Binär-Zählers der einen DAC durchschaltet variieren, abzutasten.

Bipolarer Transistor

Zuerst wird der Kennlinienschreiber für den bipolaren Transistor verwendet. Aus den Oszillogrammen aus Abb. 9, 10, 11 und 12 lassen sich die Kollektorströme ablesen und sind in Tab. 1 dargestellt.

| # | dU_C |
|---|--------|
| 1 | 1.67 V |
| 2 | 1.67 V |
| 3 | 1.60 V |
| 4 | 1.60 V |

Tabelle 1: Differenzen der Kollektorströme.

Gemittelt erhalten wir 1.64(6) V, wobei die Standardabweichung 0.035 V beträgt, diese aber kleine ist, als die geschätzten 0.06 V Messunsicherheit. Somit folgt

$$\beta = \frac{dI_C}{dI_B} = 547(27)$$

$$\text{mit } dI_B = 6 \mu\text{A und } dI_C = \frac{dU_C}{500\Omega} = 3.28(16) \text{ mA.}$$

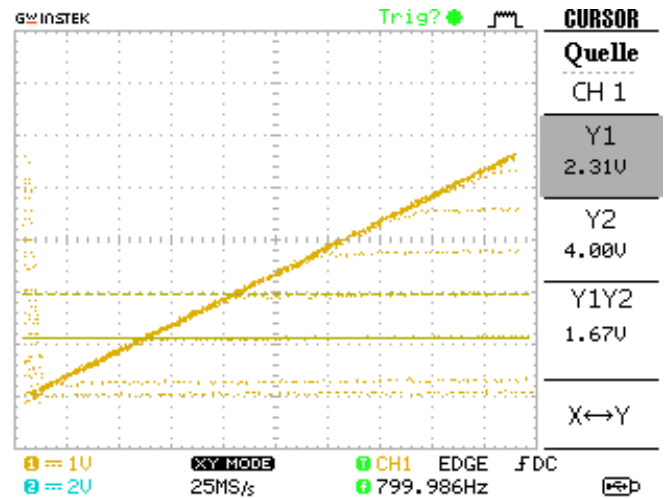


Abbildung 10: Oszillogramm für # = 2

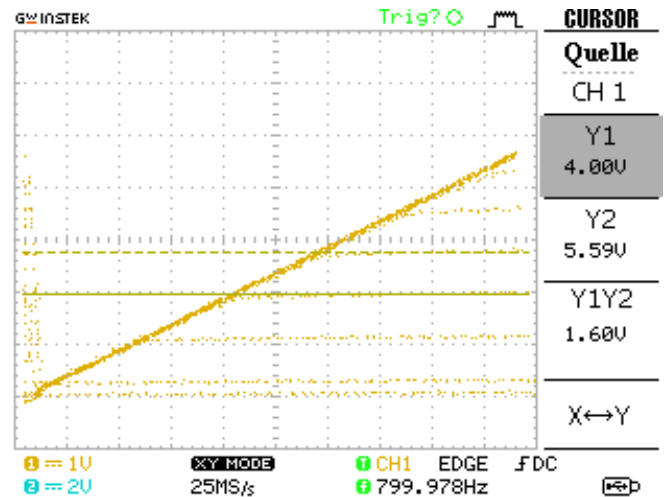


Abbildung 11: Oszillogramm für # = 3

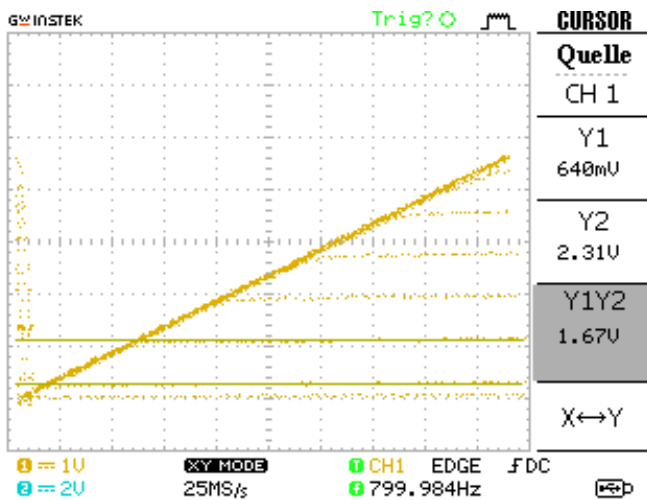


Abbildung 9: Oszillogramm für # = 1

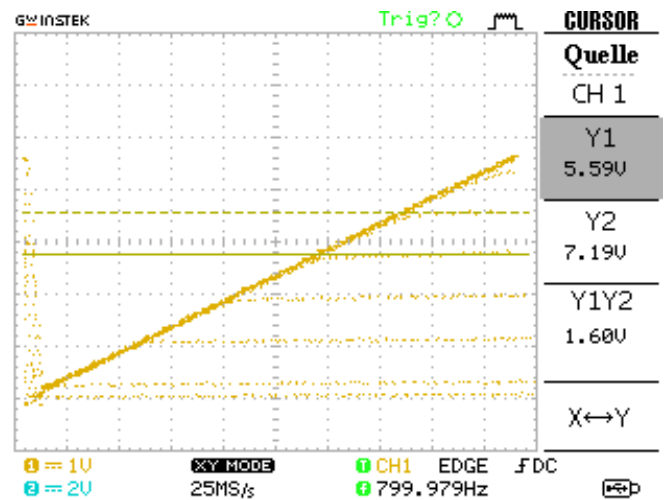


Abbildung 12: Oszillogramm für # = 4

Legen wir nun die Arbeitsgerade durch eines der Oszillogramme, so können wir dessen Arbeitspunkt bestimmen. Dafür legen wir eine Gerade von $(U_{CE} = 0 \text{ V}; I_C = 19.2 \text{ mA} \hat{=} U_C = 9.61 \text{ V})$ bis $(U_{CE} = 10 \text{ V}; I_C = 6.4 \text{ mA} \hat{=} U_C = 3.2 \text{ V})$, wobei wir mit 500Ω geeicht haben. Die Gerade lässt sich mathematisch beschreiben mit

$$I_C = \frac{U_0 - U_{CE}}{R_C + R_E}$$

mit $R_C = R_E = 390 \Omega$ und $U_0 = 15 \text{ V}$.

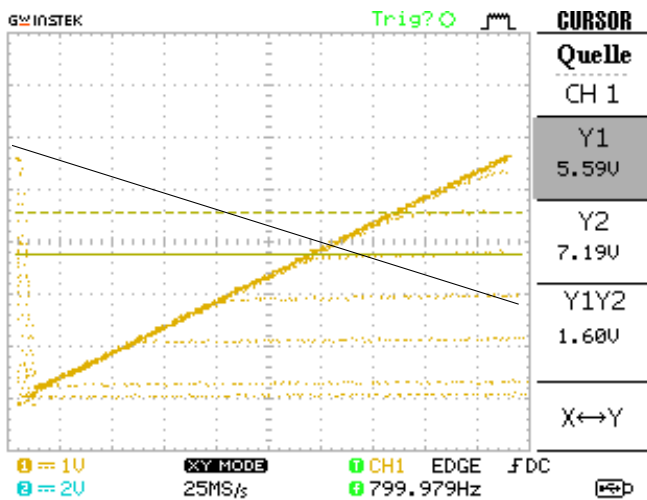


Abbildung 13: Kennlinien mit Arbeitsgerade (schwarze Linie)

An diesem Punkt stellt sich heraus, dass es wohl von Vorteil gewesen wäre das Bild des Oszillographen verkleinert dargestellt zu haben. Außerdem müssten wir die 10. Kennlinie identifizieren können, wenn wir den Arbeitspunkt bei $I_B = 60 \mu\text{A}$ ablesen wollten. Dies geht bei uns leider nicht. Anhand von vorherigen Protokollen und vergleichen der 5. Linie spekulieren wir aber, dass wir eine Spannung $U_{CE} \approx 2 \text{ V} \dots 4 \text{ V}$ haben.

FET

Nun nehmen wir mit einem Vorwiderstand und dem Kennlinienschreiber die Kennlinien eines FETs (Feldeffekttransistors) auf. Zusätzlich verwenden wir ein Potentiometer, um die Spannung an dem Gate einzustellen. So wird nun mit dem Potentiometer ein Oszillogramm so eingestellt, dass möglichst viele Linien und die letzte Linie zu sehen ist. Die letzte Linie ist daran zu identifizieren, dass es keine Abzweigung nach oben mehr gibt. Diese Bedingung wurde erfüllt und in Abb. 14 präsentiert.

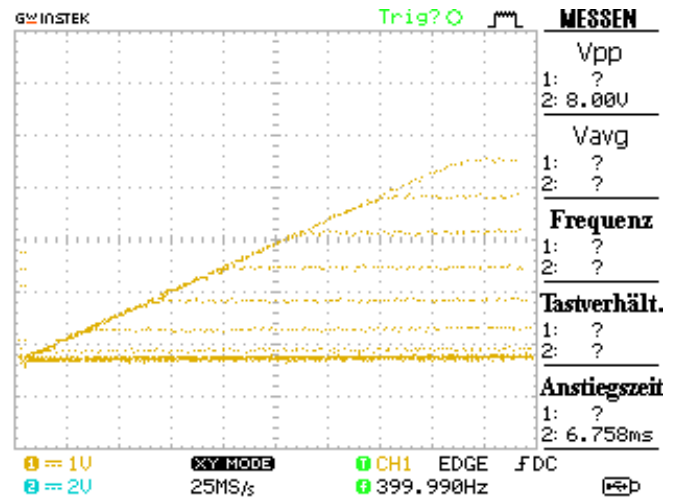


Abbildung 14: FET

Wir erhalten für das vorliegende Oszillogramm einen Widerstand an dem Potentiometer von $R = 30.6(9) \text{ k}\Omega$ und somit $dU_{GS} = R \cdot 6 \mu\text{A} = 183.6(54) \text{ mV}$

Nun lässt sich die Drainspannungen U_D ablesen und mit dem Eichwiderstand $R = 500 \Omega$ in den Drainstrom

$$I_D = \frac{U_D}{R}$$

umrechnen. Die Drainspannung ist an dem Oszillogramm auf der x-Achse abzulesen, sobald sie konstant ist, wobei die unterste Linie bei 0 V liegt. So lässt sich jetzt auch eine Spannung über Gate-Source berechnen:

$$U_{GS} = R_P \cdot n \cdot 6 \mu\text{A} - I_D \cdot 100 \Omega$$

mit $R_P :=$ Widerstand am Potentiometer
und $n :=$ n-te Linie von unten.

Hierbei wurde die Gate-Source-Spannung um den Term $I_D \cdot 100 \Omega$ korrigiert, da diese an der Source abfällt. Wir haben das Ergebnis Graphisch in Abb. 15 dargestellt. Ein Plot mit der Wurzel in Abb. 16 zeigt die Linearität im Quadrat für höhere n .

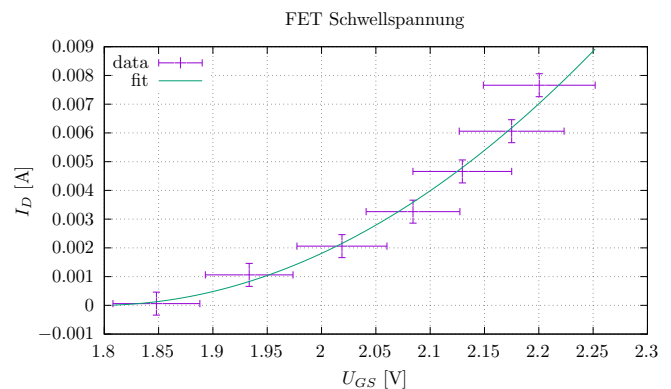


Abbildung 15: Schwellspannung des FETs. Werte sind Tab. 3 zu entnehmen.

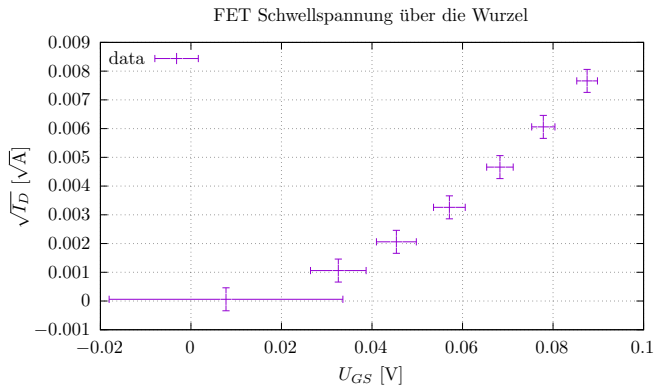


Abbildung 16: Schwellspannung des FETs mit Wurzel. Werte sind Tab. 4 zu entnehmen.

Mit einem Fit der Form

$$I_D = k \cdot (U_{GS} - U_{thr})^2$$

erhalten wir folgende Werte der Parameter:

| Parameter | Wert |
|-----------|-----------------------------|
| k | 0.0425(47) A/V ² |
| U_{thr} | 1.794(17) V |

Tabelle 2: Fit-Parameter und Werte

Hierbei konvergierte unsere Minimierungsfunktion mit $\chi/\text{dof} = 0.077$ überraschend gut. Um nun die Transkonduktanz zu berechnen wird über die Differenzen der Drain-Ströme und Gate-Source-Spannungen genommen und über deren Quotient gemittelt. Hierbei ergibt sich der Fehler aus der Varianz. Somit erhalten wir eine Transkonduktanz von $g_m = 0.028(18)$. Diese lässt sich allerdings auch Experimentell mit $g_m \approx 2 \cdot \sqrt{k \cdot I_D}$ berechnen und ergibt so gemittelt $g_m = 0.022(11)$. Die beiden Ergebnisse sind aufgrund der relativ großen Unsicherheiten ($\approx 50\%$) verträglich.

| Schwellspannung des FETs | |
|--------------------------|------------------|
| $U_{GS} \cdot 10^2$ | $I_D \cdot 10^5$ |
| 184.8 ± 4.0 | 6.0 ± 40.0 |
| 193.3 ± 4.0 | 106.0 ± 40.0 |
| 201.9 ± 4.1 | 206.0 ± 40.0 |
| 208.4 ± 4.3 | 326.0 ± 40.0 |
| 213.0 ± 4.5 | 466.0 ± 40.0 |
| 217.5 ± 4.8 | 606.0 ± 40.0 |
| 220.0 ± 5.1 | 766.0 ± 40.0 |

Tabelle 3: Werte für die Schwellspannung des FETs

| Schwellspannung des FETs mit Wurzel | |
|-------------------------------------|---|
| $U_{GS} [\text{V}] \cdot 10^2$ | $\sqrt{I_D} [\sqrt{\text{A}}] \cdot 10^4$ |
| 184.8 ± 4.0 | 80.0 ± 260.0 |
| 193.3 ± 4.0 | 326.0 ± 61.0 |
| 201.9 ± 4.1 | 454.0 ± 44.0 |
| 208.4 ± 4.3 | 571.0 ± 35.0 |
| 213.0 ± 4.5 | 683.0 ± 29.0 |
| 217.5 ± 4.8 | 778.0 ± 26.0 |
| 220.0 ± 5.1 | 875.0 ± 23.0 |

Tabelle 4: Werte für die Schwellspannung des FETs mit Wurzel

5 Fazit

Die Kennlinien vom bipolaren Transistor, sowie von dem FET, konnten gut dargestellt werden. Dabei war leider die Ausführung etwas ungründlich, weswegen wir einen Wert nur spekulativ abschätzen konnten. Neben dem gab es allerdings bei der Bestimmung der Schwellspannung $U_{thr} = 1.794(17)$ V und Transkonduktanz $g_m = 0.028(18)$ bzw. experimentell: $g_m = 0.022(11)$, keine größeren Probleme und die Werte decken sich gut.

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Schaltbild und Aufbau eines Bipolartransistors; Abbildung 3/4.1 a) [1] | 1 |
| 2 | Aufbau eines FET; Abbildung 3/4.8 [1] | 1 |
| 3 | Potentialverlauf ohne und mit äußerer Spannung | 1 |
| 4 | Schaltbild Kennlinienschreiber; Abbildung 3.1 [1] | 2 |
| 5 | Vereinfachtes Schaltbild Kennlinienschreiber | 2 |
| 6 | Ausgangskennlinienfeld Bipolartransistor mit EIN und AUS Schaltung | 2 |
| 7 | Schaltkreis zum Steuern einer Lampe | 2 |
| 8 | Schaltbild Kennlinienschreiber | 2 |
| 9 | Oszillogramm für $\# = 1$ | 3 |
| 10 | Oszillogramm für $\# = 2$ | 3 |
| 11 | Oszillogramm für $\# = 3$ | 3 |
| 12 | Oszillogramm für $\# = 4$ | 3 |
| 13 | Kennlinien mit Arbeitsgerade (schwarze linie) | 4 |
| 14 | FET | 4 |
| 15 | Schwellspannung des FETs. Werte sind Tab. 3 zu entnehmen. | 4 |
| 16 | Schwellspannung des FETs mit Wurzel. Werte sind Tab. 4 zu entnehmen. | 5 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Differenzen der Kollektorströme. | 3 |
| 2 | Fit-Parameter und Werte | 5 |
| 3 | Werte für die Schwellspannung des FETs | 5 |
| 4 | Werte für die Schwellspannung des FETs mit Wurzel | 5 |

Literatur

- [1] Fabian Hügging. *Elektronik-Praktikum Versuchsanleitung*. Universität Bonn, kurs b edition, 2024.